

PCTWELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales BüroINTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation ⁷ : C01G 19/00, H01B 1/08		A1	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 00/14017
			(43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 16. März 2000 (16.03.00)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP99/06498		(81) Bestimmungsstaaten: CN, CZ, HU, JP, KR, PL, TR, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).	
(22) Internationales Anmeldedatum: 3. September 1999 (03.09.99)			
(30) Prioritätsdaten: 198 40 527.8 6. September 1998 (06.09.98) DE 198 49 048.8 23. Oktober 1998 (23.10.98) DE		Veröffentlicht <i>Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.</i>	
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): INSTITUT FÜR NEUE MATERIALEN GEM. GMBH [DE/DE]; Im Stadtwald, Gebäude 43a, D-66123 Saarbrücken (DE).			
(72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): NONNINGER, Ralph [DE/DE]; Rebenschreie 48, D-66129 Saarbrücken-Güdingen (DE). GOEBBERT, Christian [DE/DE]; Grossherzog-Friedrich-Strasse 73, D-66111 Saarbrücken (DE). SCHMIDT, Helmut [DE/DE]; Im Königsfeld 29, D-66130 Saarbrücken-Güdingen (DE). DRUMM, Robert [DE/DE]; Mehringer Weg 13, D-66113 Saarbrücken (DE). SEPEUR, Stefan [DE/DE]; Kirchstrasse 22, D-66787 Wadgassen-Schafhausen (DE).			
(74) Anwalt: BARZ, Peter, Kaiserplatz 2, D-80803 München (DE).			
(54) Title: METHOD FOR PREPARING SUSPENSIONS AND POWDERS BASED ON INDIUM TIN OXIDE AND THE USE THEREOF			
(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON SUSPENSIONEN UND PULVERN AUF BASIS VON INDIUM-ZINN-OXID UND DEREN VERWENDUNG			
(57) Abstract			
Suspensions and powders based on indium tin oxide are prepared as follows: indium tin oxide precursors are precipitated in one or more solvents in the presence of one or more surface-modified components from solutions; the powder obtained is calcined after removing the solvent; one or more surface-modified components and one or more solvents are then added; the mixture obtained is subjected to a grinding or dispersion treatment to form a suspension and optionally liquid components from the suspension are removed in order to obtain a powder. Optionally, the powder obtained can be formed into a shaped body by means of a shaping process. The indium tin oxide materials thus obtained are particularly suitable as coating material for microelectronic and optoelectronic applications.			
(57) Zusammenfassung			
Suspensionen und Pulver auf der Basis von Indium-Zinn-Oxid werden dadurch hergestellt, daß man Indium-Zinn-Oxid-Vorstufen in Gegenwart einer oder mehrerer oberflächenmodifizierender Komponenten aus Lösungen in einem oder mehreren Lösungsmitteln ausfällt, das erhaltene Pulver nach Entfernung des Lösungsmittels calciniert, dann eine oder mehrere oberflächenmodifizierende Komponenten und ein oder mehrere Lösungsmittel zugibt, die erhaltene Mischung einer Zerkleinerungs- oder Dispergierungsbehandlung unter Bildung einer Suspension unterwirft und gegebenenfalls flüssige Komponenten aus der Suspension abtrennt, um ein Pulver zu erhalten. Gegebenenfalls kann das erhaltene Pulver über ein Formgebungsverfahren in einen Formkörper überführt werden. Die so hergestellten Indium-Zinn-Oxid-Materialien eignen sich insbesondere als Beschichtungsmaterial für mikro- und optoelektronische Zwecke.			

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Leitland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	ML	Mali	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	MN	Mongolei	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MR	Mauretanien	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MW	Malawi	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MX	Mexiko	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CG	Kongo	KE	Kenia	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	PL	Polen		
CM	Kamerun	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CN	China	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CU	Kuba	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
CZ	Tschechische Republik	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DE	Deutschland	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
DK	Dänemark	LR	Liberia	SG	Singapur		
EE	Estland						

Verfahren zur Herstellung von Suspensionen und Pulvern auf Basis von Indium-Zinn-Oxid und deren Verwendung

Die Erfindung betrifft Suspensionen und Pulver auf Basis von Indium-Zinn-Oxid, 5 Verfahren zu deren Herstellung, daraus hergestellte Formkörper sowie Beschichtungs- und Formmassen und deren Verwendung als Beschichtungsmaterialien.

Indium-Zinn-Oxide sind durch ihre optoelektronischen Eigenschaften gekenn- 10 zeichnet. Sie sind z. B. in Form von dünnen transparenten Schichten in der Lage Infrarotlicht zu reflektieren und zeichnen sich gleichzeitig durch eine relativ hohe elektronische Leitfähigkeit bei vorhandener Transparenz in Schichtsystemen aus. Aus diesem Grunde gibt es sehr viele Anwendungsmöglichkeiten für Indium-Zinn- 15 Oxid (ITO)-Systeme, und dementsprechend auch sehr viele Untersuchungen zu ihrer Herstellung.

Die gängigsten Verfahren zum Auftragen von transparenten Schichten sind Gaspha- 20 sentechniken, bei denen das ITO aus der Gasphase auf das Substrat in Form einer zusammenhängenden dünnen Schicht abgeschieden wird. Als andere Verfahren werden der Sol-Gel-Prozeß oder Pulver- und Pastentechnologien verwendet.

Das Stoffsystem Indium und Sauerstoff ist durch eine Vielzahl von Verbindungen gekennzeichnet. Die thermodynamisch stabilste ist In_2O_3 . Indiumoxide der Zusam- 25 mensetzung In_4O_3 , In_4O_5 , In_2O und In_7O_9 werden üblicherweise durch Reduktion von In_2O_3 in Wasserstoffstrom gebildet. In_2O_3 ist bei Zimmertemperatur dunkelgelb bis hellgelb, bei höheren Temperaturen braun bis braunrot und in Mineralsäuren löslich. Röntgenographisch kann nur die kubische Modifikation nachgewiesen werden.

Zur Herstellung reiner Indiumoxidpulver wird in der Literatur überwiegend die 30 Präzipitation aus Lösungen beschrieben. Die gewählten Hydroxide werden danach durch Calcinieren in die Oxide überführt. Wäßrige Salzlösungen werden mit

Alkalilösungen, mit Ammoniak oder mit Harnstoff gefällt; siehe z.B. JP 06227815 A2, JP 05193939 A2, JP 04325415 A2, JP 04219315 A2 und DE 2127135 A.

Bisweilen erfolgt die Fällung auch in Gegenwart von Schwefelsäure oder Sulfatlösungen; siehe z.B. JP 05058627 A2. Es finden sich jedoch keine Angaben über den Einfluß des Fällungsmittels auf die Pulverqualität. Auch enthält die Literatur keine oder sehr ungenaue Angaben zu Partikelgröße oder Agglomerationszustand. Die Partikelgrößen, die in der Regel aus den Messungen der BET-Oberfläche der Pulver zurückgerechnet werden, erstrecken sich vom Nanometerbereich bis in den Bereich von 100 µm.

Indiumoxid ist ein wide-gap n-Halbleiter, dessen intrinsische Elektronenleitung auf Sauerstofffehlstellen beruht. Die Mobilität der Ladungsträger wird neben intrakristallinen Effekten vor allem durch die Behinderung interkristalliner Elektronenübergänge beschränkt. Eine Möglichkeit, die geringe Ladungsträgerdichte des reinen Indiumoxids zu erhöhen, ist der gezielte Einbau von vierwertigen Elementen wie z. B. Zinn.

Es sind verschiedene Arten der Herstellung von Indiumoxid-Zinnoxid-Gemischen bekannt. Beim einfachen Mixed-Oxide-Verfahren zur Herstellung von ITO-Gemischen werden Temperaturen zwischen 700°C und 900°C benötigt; siehe z.B. EP 654447 A1. Die Sol-Gel-Technik eignet sich ebenfalls zur Herstellung von ITO-Gemischen, wobei spezifische Pulveroberflächen von 10 m²/g angegeben werden; siehe z.B. JP 06293517 A, JP 06080422 A und JP 05201731 A. Weiter werden Elektrolyseverfahren beschrieben, bei denen durch anodische Oxidation einer Indiumelektrode bzw. einer Indiumzinnelektrode Hydroxide erzeugt werden, die man durch nachfolgendes Calcinieren in Oxide umwandelt; siehe JP 63195101 A2, JP 06171937 A2 und JP 06329415 A2. Es werden auch Indiumzinnhydroxide in organischen Lösungsmitteln dispergiert, durch azeotrope Destillation dehydriert und anschließend durch Trocknen und Calcinierung in die Oxide überführt; siehe JP 02006332 A2. ITO-Pulver lassen sich auch durch eine Lichtbogenentladung zwischen einer Wolframelektrode und einer Indiumelektrode in einem Argon-

Sauerstoff-Gemisch (Y. Endo et al., Funtai, Kogaku Kaishi (1995), 32 (12), 874-80) bzw. mittels Aerosolsprühpyrolyse von Indiumacetat in Wasser in einem Argonträgergas (D.M. Speckmann et al., Mater. Res. Soc. Symp. Roc. (1995), 372 (Hollow and Solid Sphere and Microspheres: Science and Technology Associated 5 with Their Fabrication and Application), 247-52 oder durch Versprühen von Indium-zinnsalzlösungen bei 800°C herstellen (JP 01087519 A). Über eine Kondensation von Indiumchlorid und Zinnchlorid aus der Gasphase und nachfolgender Reaktionen mit Sauerstoff oder Wasser läßt sich Indiumoxid oder Zinnoxid ebenso herstellen (JP 05024836 A2) wie durch eine Koronaentladung in reduzierender Atmosphäre bei 10 1000°C (DE 4407774 C1).

Zur Herstellung von ITO-Schichten werden z.B. direkt ITO-Pulver eingesetzt. So verwenden z.B. die JP 07118840 A ein ITO-Pulver mit einer spezifischen Oberfläche von 30 m²/g, die JP 06049394 A ein ITO-Pulver mit einem Durchmesser von 200 nm 15 und die JP 05036314 A ein ITO-Pulver mit einer mittleren Partikelgröße von 30 nm.

Zusammenfassend bedeutet dies, daß eine Vielzahl an Herstellungsverfahren für zinndotierte Indiumoxid (ITO)-Pulver vorliegen. Definierte Angaben über Pulverqualitäten in Verbindung mit ihrer Herstellungsweise sind jedoch nicht beschrieben. Die 20 Qualität der eingesetzten Pulver wird üblicherweise über die Anwendung definiert. In den letzten Jahren hat das Interesse an einer definierten Herstellung und Anwendung transparenter leitfähiger Schichten auf verschiedenen Substraten stark an Bedeutung gewonnen. Während die Anwendung Sb- und F-dotierter Zinnoxid-schichten auf Glassubstraten aufgrund ihrer Leitfähigkeit, ihrer Transparenz im 25 sichtbaren Spektralbereich und ihrer Reflektionseigenschaften im IR-Bereich für die Oberflächenbeheizung von Gläsern für Flugzeuge, Raumschiffe, Kameras und auch für elektrostatische Abschirmzwecke schon lange bekannt ist, sind in neuerer Zeit vielfältige Anforderungen an derartige Schichten für die Anwendungen in der Mikro- und Optoelektronik entstanden. Dazu gehören z. B.

30

1. transparente Ansteuerelektroden für Flüssigkeitsdisplays, Dünnschichtelektro-lumineszenz-Displays und Elektrochromie-Displays

2. transparente leitfähige Schichten für hochempfindliche Strahlungsdetektoren, ferroelektrische Photoleiter und Speicheranordnungen
3. transparente leitfähige Oxidfilme als Gate-Elektroden für Ladungs-, Injektions- und ladungsgekoppelte Anordnungen.

5

Diese Anwendungen in der Optoelektronik sind gleichfalls mit höheren Anforderungen an die Leitfähigkeit, Transparenz und Strukturierbarkeit der Schichten verbunden. Aufgrund der ungünstigen Strukturierungseigenschaften dotierter Zinn-oxidschichten bei der üblichen Strukturierung durch chemische Ätztechnologien

10 haben sich für diese Anwendungen überwiegend zinndotierte Indiumoxidschichten (ITO) durchgesetzt.

Weiterhin zeigen diese ITO-Schichten im Vergleich zu dotierten Zinnoxidschichten eine wesentlich bessere Leitfähigkeit und Transparenz. Zinndotierte Indiumoxid-

15 schichten stellen zur Zeit die leitfähigsten Beschichtungen dar, die kommerziell erhältlich sind. Im Routinebetrieb liegt der erreichbare spezifische Widerstand bei etwa $1 - 2 \times 10^4$ Ohm.cm, was in Verbindung mit einer etwa 30 nm dicken Sperrschicht aus SiO_2 bereits bei 120 nm Schichtdicke zu einem Flächenwiderstand von $15 \Omega/\square$ führt. (Transparenz > 90%). Bedingt durch die Herstellung im Sputter-
20 bzw. CVD-Verfahren sind die Kosten für diese Art der Beschichtung vergleichsweise hoch und großflächige Beschichtungen sind nur schwer durchzuführen.

Die hohe Ladungsträgerdichte in Verbindung mit einer Ladungsträgermobilität im Bereich von $40 - 60 \text{ cm}^2/\text{Vs}$ führt zu einer sehr hohen Transparenz im sichtbaren

25 Bereich, bei gleichzeitig hervorragender Reflexion im IR-Bereich. Der Anteil an Zinnoxid liegt üblicherweise zwischen 7 - 12 Gew.%.

Für viele Anwendungsgebiete, insbesondere in der Mikro- und Optoelektronik, bei optischen und IR blockierenden Beschichtungen ist es wichtig, daß ITO-Pulver

30 verwendet werden, die aus nanoskaligen Partikeln bestehen. Solche nanoskaligen Partikel weisen eine durchschnittliche Teilchengröße von bevorzugt nicht mehr als 200

nm, insbesondere nicht mehr als 50 nm und besonders bevorzugt nicht mehr als 30 nm auf. Ein besonders bevorzugter Bereich liegt bei 5 bis 30 nm.

Bei vielen Verfahren zur Herstellung von Indium-Zinn-Oxid-Pulvern oder -Suspensionen werden Suspensionen von Vorstufen des Indium-Zinn-Oxid-Pulvers erhalten, aus denen nach Trocknung die Indium-Zinn-Oxid-Pulver durch Calcinierung hergestellt werden. Die Partikelgrößen der so hergestellten Pulvern liegen aber nicht im gewünschten nm-Bereich und die Pulver können auch nicht wieder zu Suspensionen mit Partikelgrößen im nm-Bereich (nanoskalige Partikel) aufgearbeitet werden, so daß mit derart hergestellten dünnflüssigen Suspensionen keine Beschichtungen über Tauch-, Sprüh- oder ähnliche Verfahren mit Partikelgrößen im nm-Bereich hergestellt werden können.

Zwar entstehen bei der Bildung der ITO-Pulvervorstufen in Suspension unter den geeigneten Bedingungen nanoskalige Primärpartikel geeigneter Größe, bei der Aufarbeitung, insbesondere bei der Calcinierung, aggregieren diese Primärpartikel aber zu größeren Partikeln. Diese Aggregatbildung ist darauf zurückzuführen, daß mit abnehmender Partikelgröße auch schwache Wechselwirkungs Kräfte, wie z.B. van der Waals-Kräfte, erheblich an Bedeutung gewinnen bzw. dominieren. Hinzu kommt, daß die Partiktoberfläche immer mit funktionellen, d.h. kondensationsfähigen, Gruppen belegt ist, die durch Kondensationsreaktionen zwischen einzelnen Primärpartikeln zur Bildung harter Aggregate führen. Die Primärpartikel sind dann quasi über Sinterhälse miteinander verbunden. Diese aus Primärpartikeln bestehenden Aggregate können durch einen einfachen Dispergierungsschritt in einem nichtwässrigen oder wässrigen Lösungsmittel nicht mehr aufgebrochen werden.

Derartige über eine Calcinierung hergestellte Pulver können nicht für hochtransparente Schichten verwendet werden, da Partikel mit Größen über 50 nm schon zu optischen Störungen führen.

30

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es daher, Zusammensetzungen auf der Basis von Indium-Zinn-Oxid so herzustellen, daß trotz Calcinierung nanoskalige

Partikel mit geeigneter Größe erhalten werden und die Pulver in einem einfachen Dispergierungsschritt zu Suspensionen verarbeitet werden können, wobei die Primärpartikelgröße vollständig erhalten bleibt.

- 5 Dies gelingt erfindungsgemäß durch ein Verfahren zur Herstellung von Suspensionen und Pulvern auf Basis von Indium-Zinn-Oxid, das dadurch gekennzeichnet ist, daß man
 - a) Indium-Zinn-Oxid-Vorstufen aus Lösungen von Indium- und Zinn-Verbindungen in einem oder mehreren Lösungsmitteln in Gegenwart einer oder mehrerer 10 oberflächenmodifizierender Komponenten ausfällt,
 - b) das erhaltene Pulver nach Entfernung des Lösungsmittels calciniert,
 - c) eine oder mehrere oberflächenmodifizierende Komponenten und ein oder mehrere Lösungsmittel zugibt,
 - d) die erhaltene Mischung einer Zerkleinerungs- oder Dispergierbehandlung unter 15 Bildung einer Suspension unterwirft und
 - e) gegebenenfalls flüssige Komponenten aus der Suspension abtrennt, um ein Pulver zu erhalten.

Ferner können gegebenenfalls die Suspension oder das daraus hergestellte Pulver 20 über ein Formgebungsverfahren in einen Formkörper überführt werden.

In dem erfindungsgemäßen Verfahren werden überraschenderweise Suspensionen und Pulver auf Basis von Indium-Zinn-Oxid erhalten, die im wesentlichen aus Primärpartikeln bestehen und im wesentlichen keine durch Aggregation von 25 Primärpartikeln gebildete Agglomerate enthalten. Die Pulver lassen sich leicht zu Suspensionen redispergieren, in denen die Primärpartikelgröße praktisch vollständig erhalten bleibt.

Unter einem Indium-Zinn-Oxid-Pulver, das auch als ITO-Pulver bezeichnet wird, wird 30 ein Pulver verstanden, das im wesentlichen aus einem Mischoxid von Indium und Zinn besteht. Das Indium und das Zinn können darin in einer oder in verschiedenen Oxidationsstufen vorliegen. Beispielsweise liegen $\text{In}^{(+I)}$ und/oder $\text{In}^{(+III)}$ sowie

Sn(+II) und/oder Sn(+IV) vor. Sn liegt bevorzugt als Sn(+IV) vor. Gegebenenfalls können Indium und Zinn auch teilweise als In(0) oder Sn(0) vorliegen. Auf der Oberfläche der Partikel des ITO-Pulvers sind auch die nachstehend beschriebenen oberflächenmodifizierenden Komponenten vorhanden.

5

Bevorzugt handelt es sich bei dem ITO-Pulver um ein zinndotiertes Indiumoxid, d.h. der Anteil an Zinnoxid ist geringer als der Anteil an Indiumoxid. Der Anteil an Zinnoxid bezogen auf das Indium-Zinn-Oxid, ohne Berücksichtigung der oberflächenmodifizierenden Komponente, beträgt beispielsweise 2 bis 30 Mol-%, bevorzugt 7 bis 10 12 Mol-%. Das ITO-Pulver kann beispielsweise, ohne Berücksichtigung der oberflächenmodifizierenden Komponente, durch die Formel $\text{In}_{2-y}\text{Sn}_y\text{O}_3$ mit $0 \leq y < 2$, insbesondere $0 \leq y < 1$ ausgedrückt werden (Ladungsüberschuß: e_y^-).

Selbstverständlich kann das Indium-Zinn-Oxid-Pulver Verunreinigungen enthalten.

15 Der akzeptierbare Grad hängt vom Verwendungszweck ab. Über die Edukte kann z. B. SO_4^{2-} , Ca, Co, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn, K oder Na enthalten sein. Durch Verwendung reiner Edukte können SO_4^{2-} , Ca, Co, Cu, Fe, Ni, Pb und Zn auf unter 0,005 Gew.-% und Na, K auf unter 0,01 Gew.% gebracht werden. Über das Verfahren kann z. B. NH_4^+ und Cl^- in das Produkt gelangen, das je nach Anzahl der Waschzyklen 20 praktisch gänzlich entfernt werden kann. Bezogen auf das Indium-Zinn-Oxid-Pulver sind aber unter Berücksichtigung der oberflächenmodifizierenden Komponente weniger als 5 Gew.-%, bevorzugt weniger als 1 Gew.-%, insbesondere bevorzugt weniger als 0,1 Gew.-% Verunreinigungen enthalten.

25 In dem erfindungsgemäßen Verfahren werden aus Lösungen von Indium- und Zinn-Verbindungen Indium-Zinn-Oxid-Vorstufen in Gegenwart einer oder mehrerer oberflächenmodifizierender Komponenten aus einem oder mehreren Lösungsmitteln ausgefällt.

30 Bei dem Fällungsprozeß bzw. dem Co-Fällungsprozeß kann es sich um jedes hierfür nach dem Stand der Technik bekannte Verfahren handeln. Die Fällung kann beispielsweise über ein Sol-Gel-Verfahren, ein Elektrolyseverfahren, ein

beispielsweise über ein Sol-Gel-Verfahren, ein Elektrolyseverfahren, ein Dehydrierungsverfahren oder ein Aerosolsprühpyrolyseverfahren, wie sie vorstehend beschrieben wurden, durchgeführt werden. Bevorzugt erfolgt die Fällung aber durch ein Sol-Gel-Verfahren. Bei dem Sol-Gel-Verfahren werden bei 5 Anwesenheit von Wasser z.B. durch Zusatz von Basen oder Säuren Hydrolyse- und Kondensationsreaktionen eingeleitet, die zur Fällung von Hydroxo(Oxo)-kondensaten führen. Dabei werden zur Fällung der Indium-Zinn-Oxid-Vorstufen besonders bevorzugt Basen, insbesondere primäre, sekundäre, tertiäre aliphatische oder aromatische Amine, Tetramethylammoniumhydroxid, NaOH, KOH, Ammoniak, 10 Ammoniumhydroxid oder Mischungen davon eingesetzt. Besonders bevorzugt wird Ammoniumhydroxid für die Fällung eingesetzt.

Als Indium- und Zinn-Verbindungen können alle Indium- bzw. Zinn-Verbindungen eingesetzt werden, aus denen durch Fällung und gegebenenfalls anschließender 15 Nachbearbeitung, wie beispielsweise einer Calcinierung, Indium-Zinn-Oxid-Pulver erhalten werden können. Naturgemäß richtet sich die Wahl der Indium- und Zinn-Verbindungen nach dem eingesetzten Fällungsverfahren. Beispielsweise können bei Elektrolyseverfahren Indiumelektroden oder Indiumzinnelektroden und bei Dehydrierungsverfahren Indiumzinnhydroxide als Indium- und Zinn-Verbindungen 20 dienen.

Bevorzugte Indium- und Zinn-Verbindungen sind, insbesondere bei Sol-Gel-Fällungsverfahren, Indiumchlorid, Indiumiodid, Indiumnitrat, Indiumacetat, Indiumsulfat, Indiumalkoxide, wie Indiummethoxid oder Indiumethoxid, oder 25 Mischungen davon bzw. Zinnchlorid, Zinnsulfat, Zinnalkoxide, wie Zinnmethoxid oder Zinnethoxid, oder Mischungen davon, wobei Zinn in der Oxidationsstufe +2 oder +4 und Indium in der Oxidationsstufe +3 oder beim Chlorid und Iodid auch in der Oxidationsstufe +1 vorliegt.

30 Bei den Indium-Zinn-Oxid-Vorstufen handelt es sich im wesentlichen um Hydroxy(oxy)-Kondensate von Indium und Zinn.

Die Indium- und Zinn-Verbindungen werden gemeinsam aus einem oder mehreren Lösungsmitteln gefällt. Die Indium- und Zinn-Verbindungen sind bevorzugt vollständig in dem oder den Lösungsmittel(n) gelöst. Als Lösungsmittel werden vorzugsweise Wasser und/oder organische Lösungsmittel eingesetzt. Ein besonders

5 bevorzugtes Lösungsmittel ist destilliertes (reines) Wasser. Als organische Lösungsmittel eignen sich sowohl polare als auch unpolare und aprotische Lösungsmittel. Beispiele hierfür sind Alkohole, wie z.B. aliphatische Alkohole mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen (insbesondere Methanol, Ethanol, n- und i-Propanol und Butanol); Ketone, wie z.B. Aceton und Butanon; Ester, wie z.B. Essigsäureethylester; 10 Ether, wie z.B. Diethylether, Tetrahydrofuran und Tetrahydropyran; Amide, wie z.B. Dimethylacetamid und Dimethylformamid; Sulfoxide und Sulfone, wie z.B. Sulfolan und Dimethylsulfoxid; und aliphatische (gegebenenfalls halogenierte) Kohlenwasserstoffe, wie z.B. Pentan, Hexan und Cyclohexan. Selbstverständlich können auch Mischungen derartiger Lösungsmittel eingesetzt werden.

15

Das eingesetzte Lösungsmittel hat vorzugsweise einen Siedepunkt, der eine problemlose Entfernung desselben durch Destillation (gegebenenfalls unter Vakuum) ermöglicht. Bevorzugt werden Lösungsmittel mit einem Siedepunkt unter 200°C, insbesondere unter 150°C.

20

Die Fällung findet in Gegenwart von oberflächenmodifizierenden Komponenten statt. Bei der oder den oberflächenmodifizierenden Komponente(n) kann es sich beispielsweise um kurzkettige organische Moleküle handeln. Derartige Verbindungen weisen vorzugsweise nicht mehr als insgesamt 24, insbesondere nicht mehr als 25 insgesamt 18 und besonders bevorzugt nicht mehr als 12 Kohlenstoffatome auf. Die Anlagerung an die Oberfläche der entstehenden Primärpartikel kann beispielsweise über eine kovalente oder ionische Bindung und/oder polare (Dipol-Dipol-Wechselwirkung) oder van-der-Waals-Kräfte erfolgen. Bevorzugt weisen die oberflächenmodifizierenden Komponenten eine oder mehrere funktionelle Gruppen 30 auf. Die funktionellen Gruppen, die diese Verbindungen tragen, richten sich in erster Linie nach den Oberflächengruppen des resultierenden ITO-Pulvers und darüber hinaus auch nach der gewünschten Wechselwirkung. Beispiele für bevorzugte

funktionelle Gruppen sind Carbonsäuregruppen, Säureamidgruppen (primäre, sekundäre und tertiäre) Aminogruppen, Hydroxylgruppen und C-H-acide Gruppierungen, wie in β -Dicarbonylverbindungen. Es können auch mehrere dieser Gruppen gleichzeitig in einem Molekül vorhanden sein (Betaine, Aminosäuren, EDTA, usw.).

Demgemäß sind Beispiele für die oberflächenmodifizierenden Komponenten gesättigte oder ungesättigte Mono- und Polycarbonsäuren (vorzugsweise Monocarbonsäuren) mit 1 bis 24 Kohlenstoffatomen.

10

Beispiele für weitere geeignete oberflächenmodifizierenden Komponenten sind Mono- und Polyamine, insbesondere solche der allgemeinen Formel $R_{3-n}NH_n$, worin $n = 0, 1$ oder 2 und die Reste R unabhängig voneinander Alkylgruppen mit 1 bis 12, insbesondere 1 bis 6 und besonders bevorzugt 1 bis 4 Kohlenstoffatomen darstellen

15 (z.B. Methyl, Ethyl, n- und i-Propyl und Butyl) und Polyethylenamine; β -Dicarbonylverbindungen mit 4 bis 12, insbesondere 5 bis 8 Kohlenstoffatomen; Organoalkoxysilane, wie z.B. diejenigen, die zur Oberflächenmodifizierung von kolloidaler Kieselsäure eingesetzt werden (z.B. solche der allgemeinen Formel $R_{4-m}Si(OR')_m$ worin die Gruppen R und R' unabhängig voneinander C_1-C_4 -Alkyl darstellen und $m = 1, 2, 3$ oder 4 ist); und modifizierte Alkoholate, bei denen ein Teil der OR -Gruppen (R wie oben definiert) durch inerte organische Gruppen substituiert ist und über die noch vorhandenen OR -Gruppen eine Anbindung (Kondensation) auf der Partikeloberfläche erfolgt und die organischen Gruppen die Abschirmung übernehmen. Beispiele hierfür sind z.B. Zirkon- und Titanalkoholate $M(OR)_4$ ($M = Ti, Zr$), bei denen ein Teil der OR -Gruppen durch einen Komplexbildner, wie z.B. eine β -Dicarbonylverbindung oder eine (Mono)carbonsäure ersetzt ist.

Eine weitere Gruppe von verwendbaren oberflächenmodifizierenden Komponenten sind Tenside, z.B. kationische, anionische, nicht-ionische und amphotere Tenside.

30 Bevorzugt werden nicht-ionische Tenside, wobei Polyethylenoxid-Derivate besonders bevorzugt sind. Es kann sich dabei z. B. um Derivate mit gesättigten oder ungesättigten (Mono)carbonsäuren handeln, insbesondere mit Carbonsäuren mit mehr

als 7, bevorzugt mehr als 11 Kohlenstoffatomen, z. B. Polyethylenoxid-Derivate mit Stearin-, Palmitin- oder Ölsäure, etwa die unter der Marke „Emulsogen“ erhältlichen Produkte. Es kann sich auch um Derivate mit Sorbitanestern (Sorbitan + Carbonsäure) handeln, wobei als Carbonsäure beispielsweise die vorstehend genannten in Frage 5 kommen. Diese Produkte sind im Handel unter der Marke „Tween“ erhältlich. Weiter können Polyethylenoxid(mono)alkylether, beispielsweise mit Alkoholen mit mehr als 7, bevorzugt mehr als 11 Kohlenstoffatomen verwendet werden, z. B. die unter der Marke „Brij“ erhältlichen Produkte.

10 Konkrete Beispiele für einsetzbare oberflächenmodifizierende Komponenten sind

- Mono- und Polycarbonsäuren wie Ameisensäure, Essigsäure, Propionsäure, Buttersäure, Pentansäure, Hexansäure, Acrylsäure, Methacrylsäure, Crotonsäure, Citronensäure, Adipinsäure, Bernsteinsäure, Glutarsäure, Oxalsäure, Maleinsäure, Fumarsäure, Itaconsäure, Stearinsäure und 15 insbesondere 3,6,9-Trioxadecansäure sowie die entsprechenden Anhydride,
- Diketone wie Acetylaceton, 2,4-Hexandion, 3,5-Heptandion, Acetessigsäure, Acetessigsäure-C₁-C₄-Alkyl-ester wie Acetessigsäureethylester, Diacetyl und Acetonylaceton,
- Aminosäuren, insbesondere β -Alanin, aber auch Glycin, Valin, 20 Aminocapronsäure, Leucin und Isoleucin,
- Polyethylenoxid-Derivate, insbesondere Tween® 80 (Sorbitan-monooleat-polyoxyalkylen), aber auch Emulsogen® (Hexaglycolmonostearat), Emulsogen® OG (Ölsäurederivat) und Brij ® 30 (Polyoxyethylenlaurylether),
- Säureamide, insbesondere Caprolactam, und
- Amine wie z.B. Methylamin, Dimethylamin, Trimethylamin, Anilin, N-Methylanilin, Diphenylamin, Triphenylamin, Toluidin, Ethylendiamin, Diethylentriamin.

30 Diese oberflächenmodifizierenden Komponenten können einzeln oder als Mischung eingesetzt werden. Besonders bevorzugte Verbindungen sind 3,6,9-Trioxadecansäure, β -Alanin, Tween® 80 und Caprolactam.

Der Anteil der oberflächenmodifizierenden Komponente(n), bezogen auf das ITO-Pulver, liegt bevorzugt zwischen 2 und 30 Gew.-%, besonders bevorzugt zwischen 2 und 6 Gew.-%.

- 5 Die Fällung in Gegenwart der oberflächenmodifizierenden Komponente(n) erfolgt bevorzugt bei einer Temperatur von Raumtemperatur (20°C) bis zur Siedetemperatur des Lösungsmittels. Besonders bevorzugt sind Temperaturen im Bereich von 20 bis 100°C. Die oberflächenmodifizierenden Komponenten sind üblicherweise teilweise oder vollständig auf der Oberfläche der entstehenden
- 10 Indium-Zinn-Oxid-Pulverpartikel angelagert. Ohne an eine Theorie gebunden zu sein, wird davon ausgegangen, daß die oberflächenmodifizierenden Komponenten nach Entfernung des Lösungsmittel und der Calcinierung zumindest teilweise auf der Oberfläche der Pulverpartikel verbleiben können. Es ist aber auch möglich, daß die oberflächenmodifizierenden Komponenten im Endprodukt nicht mehr vorhanden
- 15 sind.

Anschließend wird das Lösungsmittel beispielsweise durch Filtrieren, Verdampfen und/oder Zentrifugieren und gegebenenfalls Trocknen, beispielsweise unter Vakuum und/oder erhöhter Temperatur (z.B. bei Temperaturen bis zu 250°C oder bis zu 20 200°C) oder durch Gefriertrocknen entfernt. Bei dem so erhaltenen Pulver handelt es sich üblicherweise um Partikel aus einem Indium-Zinn-Oxid/Hydroxid-Gemisch, wobei die Partikel gegebenenfalls an der Oberfläche modifiziert sind.

- Das erhaltene Pulver wird dann calciniert. Bevorzugt wird dies in einem Ofen 25 ausgeführt. Die Calcinierung erfolgt beispielsweise bei Temperaturen zwischen 200 und 400°C, bevorzugt zwischen 230 und 280°C, besonders bevorzugt 250°C. Die isotherme Haltezeit beträgt beispielsweise zwischen 15 und 120 min, bevorzugt zwischen 45 und 90 min, besonders bevorzugt 60 min.
- 30 Die Calcinierung erfolgt bevorzugt unter reduzierenden Bedingungen, wobei ebenfalls die vorstehend genannten Verfahrensbedingungen zur Anwendung kommen. Die reduzierenden Bedingungen werden bevorzugt durch Durchleiten

eines reduzierenden Gases/Gasmisches oder eines reduzierenden Dampfes erhalten. Vor Einsatz der reduzierenden Komponente kann der Ofen mit einem Inertgas, z. B. Stickstoff gespült werden. Als reduzierendes Gas/Gasmisch oder reduzierender Dampf kann beispielsweise Kohlenmonoxid, Kohlenmonoxid/

5 Stickstoff, eine Wasserdampf-Atmosphäre oder Formiergas (Wasserstoff/Stickstoff) verwendet werden. Dabei ist die Verwendung von Formiergas besonders bevorzugt. Der eingesetzte Gasfluß hängt von der Menge des zu calcinierenden Pulvers und der reduzierenden Komponente ab.

10 Sofern das Pulver nicht unter reduzierenden Bedingungen calciniert wurde, kann die Reduktion auch nach der Calcinierung durchgeführt werden, beispielsweise durch Sinterung des Pulvers oder Formkörpers unter reduzierenden Bedingungen. Zur Reduktion können dann ebenfalls die vorstehend genannten Gase/Gasmische oder Dämpfe eingesetzt werden.

15 Das calcinierte, gegebenenfalls reduzierte Pulver ist in dieser Form trotz des Einsatzes von oberflächenmodifizierenden Komponenten durch einfache Dispergierung nur noch unvollständig in eine Suspension mit Primärpartikelgröße, die üblicherweise im unteren nm-Bereich liegt, zu überführen.

20 Erfindungsgemäß wird das calcinierte Pulver einer Zerkleinerungs- oder Dispergierungsbehandlung unter Zugabe weiterer oberflächenmodifizierender Komponenten und eines oder mehrerer Lösungsmittel unterworfen. Die Zerkleinerungs- oder Dispergierungsbehandlung kann auf jede denkbare Weise erfolgen; bevorzugt handelt es sich um eine Zerkleinerungsbehandlung. Besonders bevorzugt ist die mechanische Zerkleinerungsbehandlung und/oder die Zerkleinerungsbehandlung mittels Ultraschall.

25 Der mechanische Zerkleinerungsschritt kann z. B. in Mühlen, Knetern oder Walzenstühlen durchgeführt werden. Geeignete Vorrichtungen für die mechanische Zerkleinerung sind beispielsweise Planetkugelmühlen, Rührwerkskugelmühlen und insbesondere Scherwalzenkneten, Mörsermühlen und Dreimalzenstühle. Die

Zerkleinerung, die z. B. aus Mahlen und Homogenisieren bestehen kann, wird bevorzugt bei Raumtemperatur ausgeführt. Die Dauer hängt von der Art der Mischung und der verwendeten Zerkleinerungsvorrichtung ab.

- 5 Die Zerkleinerung oder Dispergierung erfolgt unter Zusatz von einer oder mehreren oberflächenmodifizierenden Komponenten. Prinzipiell handelt es sich dabei um dieselben Verbindungen, die bereits vorstehend als oberflächenmodifizierende Komponenten für den Einsatz bei der Fällung beschrieben wurden. Dabei können in dieser Stufe dieselben Verbindungen als oberflächenmodifizierende Komponenten
- 10 eingesetzt werden, die bei der Fällung verwendet wurden. Alternativ können aber auch bei der Fällung und bei der Zerkleinerung unterschiedliche oberflächenmodifizierende Komponenten verwendet werden.

Organische Carbonsäuren und ihre Derivate, wie Anhydride und Säureamide, 15 werden bevorzugt als oberflächenmodifizierende Komponente bei der Zerkleinerung oder Dispergierung eingesetzt. Es wird auf die vorstehend aufgeführten Beispiele verwiesen. Besonders bevorzugt ist der Einsatz von 3,6,9-Trioxadecansäure.

Bei der Zerkleinerung oder Dispergierung wird die oberflächenmodifizierende 20 Komponente, bezogen auf das eingesetzte Indium-Zinn-Oxid-Pulver, bevorzugt in einer Menge von 2 bis 30 Gew.-%, besonders bevorzugt von 2 bis 10 Gew.-%, zugegeben.

Die Zerkleinerung oder Dispergierung wird bevorzugt unter Zusatz von einem oder 25 mehreren Lösungsmitteln durchgeführt. Als Lösungsmittel können die Lösungsmittel verwendet werden, die vorstehend für den Fällungsschritt beschrieben wurden. Bevorzugt werden als Lösungsmittel aber hochsiedende Flüssigkeiten verwendet. Unter hochsiedenden Flüssigkeiten werden dabei z. B. Flüssigkeiten mit einem Siedepunkt über 120°C, bevorzugt über 150°C verstanden. Bevorzugt werden 30 hochsiedende Glycole oder Glycolether eingesetzt, beispielsweise Ethylen-, Propylen- oder Butylenglycol oder die entsprechenden Di-, Tri-, Tetra-, Penta- oder Hexamere, sowie die entsprechenden Mono- oder Diether, wobei eine oder beide

Hydroxygruppen durch z.B. eine Methoxy, Ethoxy, Propoxy oder Butoxygruppe ersetzt sind. Weitere Beispiele sind Terpene, z.B. Terpineol; Polyole, z.B. 2-Methyl-2,4-pentandiol; und Polyethylenglycole und deren Ether, wie Diethylenglycol, Triethylenglycol, Tetraethylenglycol, Diethylenglycoldiethylether, Tetraethylenglycol-dimethylether oder Diethylenglycolmonobutylether. Ethylenglycol, Diethylenglycol und Diethylenglycolmonobutylether werden bevorzugt eingesetzt. Selbstverständlich können auch Mischungen aus zwei oder mehreren dieser Lösungsmittel eingesetzt werden, beispielsweise im Volumenverhältnis von 2:1 bis 1:2.

10 Das Lösungsmittel kann bei der Zerkleinerung oder Dispergierung, bezogen auf das eingesetzte Indium-Zinn-Oxid-Pulver, in einer Menge von 5 bis 150 Gew.-%, bevorzugt von 10 bis 100 Gew.-%, besonders bevorzugt von 30 bis 50 Gew.-% zugegeben werden. Eine besonders bevorzugtes Verhältnis von Pulver zu Lösungsmittel ist 75:25. Bevorzugt wird die Menge des Lösungsmittels so gewählt, 15 daß pastöse bzw. hochviskose Suspensionen erhalten werden.

Die so erhaltene ITO-Suspension kann direkt, beispielsweise für Beschichtungs-zwecke verwendet werden. Gegebenenfalls kann vorher noch zur Erhöhung der Viskosität weiteres Lösungsmittel (entweder das bereits eingesetzte oder ein 20 anderes der vorstehend beschriebenen Lösungsmittel) zugefügt werden.

Zu der ITO-Suspension können Bindemittel zugesetzt werden. Die entstehenden Beschichtungs- oder Formmassen können ebenfalls als Beschichtungsmaterial und/oder als Formkörper verwendet werden. Die Bindemittel können in solchen Mengen zugegeben werden, daß sich z.B. ein ITO-Füllgrad der Schicht von 1 bis 95 Vol.-%, bevorzugt 5 bis 80 Vol.-%, ergibt. Unter ITO-Füllgrad wird dabei die Menge an Indium-Zinn-Oxid bzw. Indium-Zinn-Oxid-Pulver in Vol.-% bezogen auf den Gesamtfeststoffgehalt der nach Auftragung auf ein Substrat und Trocknung erhaltenen Schicht verstanden.

30

Als Bindemittel können prinzipiell alle dem Fachmann bekannten anorganischen, organisch modifizierten anorganischen oder organischen Bindemittel oder

Mischungen davon eingesetzt werden. Beispiele für organische Bindemittel sind Polyvinylharze wie Polyolefine, PVC, Polyvinylalkohol, Polyvinylester oder Polystyrol, Acrylharze wie Acrylester oder Methacrylester, Alkydharze, Polyurethanlacke, Harnstoff-, Melamin-, Phenolharz-Lacke oder Celluloseester, wie Ester der

5 Cellulose mit Essigsäure oder Buttersäure.

Bevorzugt handelt es sich bei den Bindemitteln um anorganische oder organisch modifizierte anorganische Bindemittel. Beispiele für organisch modifizierte anorganische Bindemittel sind Polyorganosiloxane bzw. Silicon-Lacke. Die Polyorganosiloxane bzw. die Silicon-Lacke werden bevorzugt nach dem Sol-Gel-Verfahren hergestellt (Sol-Gel-Lack). Zur Herstellung werden bevorzugt hydrolysierbare Silane verwendet. Die hydrolysierbaren Silane können bevorzugt nicht hydrolysierbare Substituenten aufweisen.

15 Bei den hydrolysierbaren Silanen handelt es sich bevorzugt um Silane der allgemeinen Formel R_nSiX_{4-n} . Bei der oder den Gruppen X, die gleich oder verschieden sein können, und vorzugsweise identisch sind, handelt es sich um hydrolysierbare Reste. Die Reste X werden vorzugsweise aus Halogenatomen (insbesondere Chlor und Brom), Alkoxygruppen, Alkylcarbonylgruppen und
20 Acyloxygruppen ausgewählt, wobei Alkoxygruppen, insbesondere C_{1-4} -Alkoxygruppen wie Methoxy und Ethoxy besonders bevorzugt sind. n kann die Werte 1, 2 oder 3, vorzugsweise 1 oder 2 und besonders bevorzugt 1, annehmen. Die eingesetzten hydrolysierbaren Silane können auch vollständig hydrolysierbare Silane der obigen Formel, in der n gleich 0 ist, umfassen, vorzugsweise in einem
25 Anteil von weniger als 50 Mol-% auf Basis aller eingesetzten monomeren hydrolysierbaren Silane.

Die Gruppe R oder die Gruppen R, die gleich oder verschieden sein können, können Alkyl, Alkenyl, Aryl, Alkylaryl, Arylalkyl oder $R'Y$ sein. R' ist geradkettiges oder
30 verzweigtes Alkylen, das durch Sauerstoff- oder Schwefelatome oder NH-Gruppen unterbrochen sein kann, Phenylen, Alkylphenylen oder Alkylenphenylen. Y ist die funktionelle Gruppe, über die eine Vernetzung möglich ist. Beispiele für Y sind

gegebenenfalls substituierte Amino-, Amid-, Alkylcarbonyl, gegebenenfalls substituierte Anilino-, Aldehyd-, Keto-, Carboxyl-, Hydroxyl-, Alkoxy-, Alkoxycarbonyl, Mercapto-, Cyano-, Hydroxyphenyl-, Carbonsäurealkylester-, Sulfonsäure-, Phosphorsäure-, Acryloxy-, Methacryloxy-, Methacryloxy-, Glycidyloxy-, Epoxid-,
5 Hydroxyl- oder Aminogruppe.

In den vorstehenden Formeln können mehrmals vorhandene Reste R, R', X bzw. Y bei einer Verbindung jeweils die gleiche oder unterschiedliche Bedeutung haben. Es können auch Mischungen verschiedener hydrolysierbarer Silane verwendet werden.

10

Anstelle der hydrolysierbaren Silane oder (dies ist bevorzugt) in Mischung mit den hydrolysierbaren Silanen können erfindungsgemäß auch hydrolysierbare Metallverbindungen eingesetzt werden, vorzugsweise solche, die sich von Metallen der Hauptgruppen Ia, Ila, IIIa und IVa sowie den Nebengruppen IVb, Vb und VIb des
15 Periodensystems ableiten, wobei Verbindungen von Aluminium, Titan und Zirkonium (z.B. die Alkoxide von Al, Ti und/oder Zr) besonders bevorzugt sind.

Beispiele für anorganische Bindemittel sind Silicon-Lacke, die z.B. aus hydrolysierbaren Silanen hergestellt werden, die keine nicht-hydrolysierbaren
20 Substituenten aufweisen, also z.B. Verbindungen der obigen Formel R_nSiX_{4-n} , worin n = 0 und X wie vorstehend definiert ist. Anstelle oder neben diesen Silanen können auch Metallverbindungen eingesetzt werden, die sich vorzugsweise von Metallen der Hauptgruppen Ia, Ila, IIIa und IVa sowie den Nebengruppen IVb, Vb und VIb des Periodensystems ableiten, wobei Verbindungen von Aluminium, Titan und Zirkonium
25 besonders bevorzugt sind.

Ein weiteres Beispiel für ein einsetzbares anorganisches Bindemittel sind nicht vollständig kristallisierte Fällungsprodukte der vorstehend genannten Indium- und Zinn-Verbindungen. Dabei werden die gleichen Verbindungen, Bedingungen und
30 Verfahren eingesetzt, die für die Ausfällung der Indium-Zinn-Oxid-Vorstufen beschrieben sind, außer daß vorzugsweise keine oberflächenmodifizierende Komponente eingesetzt wird.

Dieses ITO-Fällungsprodukt wird gegebenenfalls getrocknet aber nicht calciniert, so daß es sich um ein nicht vollständig kristallisiertes Hydroxy(oxy)-Produkt handelt, das Oberflächen-Hydroxylgruppen aufweisen kann.

- 5 Die Bindemittel, insbesondere die anorganischen und organisch modifizierten, anorganischen Bindemittel, können auch in Form ihrer Monomere oder Vorkondensate eingesetzt werden und nach Mischung mit dem erfindungsgemäßen ITO-Pulver oder der erfindungsgemäßen ITO-Suspension weiter kondensiert werden.
- 10 Die Bindemittel können auch nanoskalige anorganische Feststoffteilchen (Nanopartikel) enthalten. Die einsetzbaren Nanopartikel haben beispielsweise eine mittlere Teilchengröße von nicht mehr als 200 nm, bevorzugt liegt der Teilchengrößenbereich unter 50 nm. Die Nanopartikel können z.B. in Form von Pulvern oder Solen zugegeben werden.
15 Die nanoskaligen anorganischen Feststoffteilchen können aus beliebigen Materialien bestehen, vorzugsweise bestehen sie jedoch aus Metallen und insbesondere aus Metallverbindungen wie beispielsweise (gegebenenfalls hydratisierten) Oxiden wie ZnO, CdO, SiO₂, TiO₂, ZrO₂, CeO₂, SnO₂, Al₂O₃, In₂O₃,
20 La₂O₃, Fe₂O₃, Cu₂O, Ta₂O₅, Nb₂O₅, V₂O₅, MoO₃ oder WO₃; Chalkogeniden wie beispielsweise Sulfiden (z.B. CdS, ZnS, PbS und Ag₂S), Seleniden (z.B. GaSe, CdSe und ZnSe) und Telluriden (z.B. ZnTe oder CdTe), Halogeniden wie AgCl, AgBr, AgI, CuCl, CuBr, CdI₂ und PbI₂; Carbiden wie CdC₂ oder SiC; Arseniden wie AlAs, GaAs und GeAs; Antimoniden wie InSb; Nitriden wie BN, AlN, Si₃N₄ und Ti₃N₄;
25 Phosphiden wie GaP, InP, Zn₃P₂ und Cd₃P₂; Phosphaten, Silikaten, Zirkonaten, Aluminaten, Stannaten und den entsprechenden Mischoxiden (z.B. solchen mit Perowskitstruktur wie BaTiO₃ und PbTiO₃).

- 30 Es können auch nanoskalige anorganische Feststoff-Teilchen eingesetzt werden, die mit polymerisierbaren und/oder polykondensierbaren organischen Oberflächengruppen versehen sind. Solche polymerisierbaren und/oder polykondensierbaren Nanopartikel und ihre Herstellung sind z.B. in der DE 197 46 885 beschrieben.

Beispiele für bevorzugte Bindemittel sind die in der DE-A-41 18 184 beschriebenen fluorhaltigen anorganischen Polykondensate und insbesondere die in der DE-A-43 38 361 beschriebenen epoxidgruppenhaltige Polyorganosiloxane.

5 Diese aus ITO-Suspension und Bindemittel erhaltene Mischung kann ebenfalls als Beschichtungsmasse und Formmasse für Beschichtungszwecke eingesetzt werden, wobei ITO-Schichten erhalten werden. Mit der Beschichtungszusammensetzung aus ITO-Pulver und Bindemittel können transparente, kratzfeste, IR-absorbierende Schichten auf allen (auch transparenten) Substraten hergestellt werden.

10

Bei der Zerkleinerung oder Dispergierung können gegebenenfalls auch zusätzlich ein oder mehrere Bindemittel zugesetzt werden. Diese können z.B. auch als Mischungen mit den eingesetzten Lösungsmitteln zugegeben werden. Beispiele für einsetzbare Bindemittel sind vorstehend beschrieben. Für die Ausführung der

15 Zerkleinerungs- oder Dispergierungsbehandlung unter Zusatz eines oder mehrerer Bindemittel gilt das gleiche, was vorstehend für die Zugabe eines oder mehrerer Lösungsmittel beschrieben worden ist. Die Mengen des eingesetzten Bindemittels können so sein, daß die vorstehend beschriebenen Füllgrade erhalten werden. Es werden dann Mischungen erhalten, die beispielsweise als Beschichtungsmasse
20 direkt für Beschichtungszwecke verwendet werden können. Prinzipiell kann das Bindemittel, sofern es eine geeignete Viskosität aufweist, auch anstelle des Lösungsmittels verwendet werden.

25 Aus der ITO-Suspension kann aber auch durch Entfernung der flüssigen Komponenten (z. B. durch Filtrieren, Verdampfen, Zentrifugieren und/oder Trocknen) ein ITO-Pulver erhalten werden. Das erhaltene ITO-Pulver ist meist im wesentlichen nanokristallin.

30 Das so erhaltene ITO-Pulver und die ITO-Suspension und ITO-Beschichtungs- und Formmassen enthalten nanoskalige kristalline Partikel von Indium-Zinn-Oxid, die überwiegend aus Primärpartikeln bestehen und praktisch nicht als Aggregate vorliegen. Durch das erfindungsgemäße Verfahren ist es somit möglich,

Pulver, Suspensionen, Formkörper und Beschichtungs- und Formmassen auf der Basis von Indium-Zinn-Oxid bereitzustellen, bei denen die Partikelgröße nicht mehr als 200 nm beträgt. Insbesondere können Partikelgrößen von unter 50 bzw. unter 20 nm und sogar von etwa 10 bis 11 nm erhalten werden. Die Partikelgröße liegt meist 5 über 2 nm, noch häufiger über 5 nm. Überraschenderweise können die so erhaltenen Pulver ohne weiteres z. B. in alkoholischen Lösungen (z.B. Ethanol), aber auch in Wasser, auf ihre vollständige Primärteilchengröße dispergiert werden, wobei die vorstehend genannte Partikelgröße erhalten bleibt, also die Primärpartikel ohne Aggregatbildung erhalten bleiben. Für die Dispergierung der ITO-Pulver können 10 prinzipiell alle geeigneten Lösungsmittel verwendet werden, beispielsweise die vorstehend für die Fällung beschriebenen Lösungsmittel.

Es ist möglich, das Indium-Zinn-Oxid als Pulver aufzubewahren und bei Bedarf z.B. entweder als Pulver selbst, als Suspension, als Beschichtungs- oder Formmasse 15 oder als Formkörper zu verwenden. Unter Beschichtungs- und Formmassen sind auch Pasten zu verstehen, die z.B. durch Umsetzung des ITO-Pulvers mit viskosen Lösungsmitteln erhalten werden. Die vorstehend genannten ITO-Materialien können vorzugsweise zur Beschichtung z.B. mittels Tauch- oder Sprühverfahren verwendet werden.

20

Aus dem ITO-Pulver lassen sich über die dem Fachmann bekannten Formgebungsverfahren Formkörper herstellen. Beispielsweise seien Extrusion, Schlickerguß, Spritzgießen, Elektrophorese, Foliengießen oder Siebdruck genannt. Es können dabei, je nach dem angewendeten Verfahren, auch Bindemittel eingesetzt werden. Als Bindemittel kommen z.B. die vorstehend genannten in Frage. 25 Als Formkörper können z. B. Schichten oder Sinterkörper, insbesondere Targets hergestellt werden. Targets werden insbesondere beim Sputter-Verfahren zur Beschichtung von Substraten eingesetzt. Ein besonderer Vorteil der erfindungsgemäßen Materialien besteht darin, daß für die Formgebung der Formkörper gegenüber den üblichen Indium-Zinn-Oxid-Materialien wesentlich 30 geringere Temperaturen benötigt werden. Die erfindungsgemäß hergestellten

Formkörper finden als Bauteile oder Funktionskörper für leitfähige Systeme in der Opto- und Mikroelektronik oder als ITO-Quelle in Sputteranlagen Verwendung.

Die erfindungsgemäß hergestellten ITO-Materialien können wie gesagt für

5 Beschichtungszwecke eingesetzt werden, wobei in dem ITO-Material ein oder mehrere Bindemittel enthalten sein können. Die zur Beschichtung geeigneten Verfahren sind die herkömmlichen und dem Fachmann bekannten. Beispiele hierfür sind Tauchen, Sprühen, Rakeln, Streichen, Bürsten und Schleudern. Zur Beschichtung eignen sich Substrate aus beliebigen Materialien, wie z.B. Kunststoff,

10 Metall, Glas, Halbleiter (z.B. Siliciumwafer) oder Keramik. Die ITO-Schichten können zur IR-Blockierung und zur Antistatikausstattung verwendet werden. Die IR-Blockierung kann z.B. durch IR-Absorption oder durch IR-Reflektion erfolgen.

Die erfindungsgemäß hergestellten ITO-Materialien finden bevorzugt als

15 Beschichtungsmaterial in der Opto- und Mikroelektronik oder für optische (transparente), IR-blockierende oder leitfähige Beschichtungen Verwendung. Außerdem können sie für Siebdruckpasten verwendet werden. Sie können beispielsweise bevorzugt eingesetzt werden für transparente Ansteuerelektroden für Flüssigkeitsdisplays, Dünnfilmelektrolumineszenz-Displays, Elektrochromie-Displays,

20 transparente leitfähige Schichten für hochempfindliche Strahlungsselektoren, ferroelektrische Photoleiter, Speicheranordnungen, transparente leitfähige Oxidfilme als Gateelektroden für Ladungs-, Injektions- und Ladungsgekoppelte Anordnungen, sowie zur Herstellung von Druckpasten, die sich für die Bedruckung von Glas, Keramik und Kunststoffen eignen, zur Abschirmung von elektromagnetischen

25 Wellen, für IR-reflektierenden Schichten bzw. Kunststoffe, leitfähige Elektroden für Solarzellen oder antistatische Filme, z.B. für Fernsehröhren, Monitore und Kontaktbildschirme.

Weitere Einsatzmöglichkeiten für die erfindungsgemäßen ITO-Materialien ist die

30 Verwendung für Plastikverscheibungen, IR-Sperren für Projektoren, IR-Sperren nach Lampen, IR-absorbierende Anstriche und Lacke, Wärmeschutzscheiben (z.B. als Beschichtung von Glasscheiben für Backöfen), Sonnenkollektoren, Schichten auf

Wärmetauschern, sowie transparente Wärmestrahlensabsorber auf Metallen, Glas, Keramiken und Kunststoffen, wie Anti(be)taubeschichtungen auf allen Substraten und Gegenständen (z.B. Fahrzeuge, Fenster, Fassaden, Instrumente, Verkehrsschilder, Hinweisschilder und Fenster von Kühlanlagen).

5

Die folgenden Beispiele erläutern die Erfindung, ohne sie zu beschränken.

Beispiele

1. Herstellung einer ITO-Suspension bzw. eines ITO-Pulvers

a) Herstellung der Vorstufe InO (OH)

10

- 140 g Indium(+III)chlorid (0,63 mol wasserfrei)
- 18 g Zinn(+IV)chlorid x 5 H₂O
- 5,6 g Caprolactam

15

werden in 1400 ml Wasser gegeben und gerührt. Nachdem eine klare Lösung entstanden ist, wird diese auf 50°C erwärmt. Nachdem die Temperatur erreicht ist, tropft man unter heftigem Rühren 105 ml Ammoniumhydroxidlösung (25%ig) zu. Die Suspension wird bei einer Temperatur von 50°C weitere 24 Stunden gerührt. Zur vollständigen Fällung werden dem Gemisch danach noch 280 ml

20

Ammoniumhydroxidlösung hinzugefügt. Es bildet sich ein weißer Niederschlag aus Indiumoxidhydroxid, der abzentrifugiert wird (30 min bei 4000 U/min). Das Pulver wird im Vakuumtrockenschrank bei 190°C so lange getrocknet, bis eine leichte Gelbfärbung des Pulvers festzustellen ist (Übergang zu kristallinem Indiumoxid).

25

b) Nachbehandlung des getrockneten Indiumoxidhydroxids

Das getrocknete Pulver wird fein gemörser, in Kristallisierschalen verteilt und in einen Formiergas-Ofen gestellt. Der Ofen wird evakuiert, dann mit Stickstoff geflutet. Der Ofen wird mit einer Heizrate von 250°C/Stunde auf 250°C aufgeheizt bei einem

Stickstofffluß von 200 Liter/Stunde. Diese Temperatur wird für 60 Minuten unter Formiergasatmosphäre bei einem Gasfluß von 300 Liter/Stunde gehalten. Danach kühlt der Ofen unter Stickstoffatmosphäre bis auf Raumtemperatur ab (Dauer: ca. 5 Stunden). Hieraus resultiert ein dunkelblaues Pulver, das mittels Röntgenanalyse als 5 reine Indiumoxidphase identifizierbar war.

c) Aufarbeitung des Indiumoxidpulvers

Variante 1

- 10 In einer Mörsermühle legt man 25 g eines Gemisches aus 50 Gew.-% Ethylenglycol, 50 Gew.-% Diethylenglycolmonobutylether (alternativ können Diethylenglycol für Ethylenglycol und/oder Dibutylenglycolether für Diethylenglycolmonobutylether verwendet werden) sowie 5,6 g 3,6,9-Trioxadecansäure vor. 75 g erfindungsgemäß hergestelltes ITO-Pulver werden langsam hinzugefügt und es wird 1 bzw. 2 Stunden 15 gemahlen. Danach ergibt sich eine dunkelblaue hochviskose Suspension, die für ca. 20 Minuten in einem Walzenstuhl homogenisiert wird. Die so erhaltene Suspension wird in Ethanol redispergiert, indem 43 g der so erhaltenen Suspension in 57 g Ethanol gegeben und gerührt werden.
- 20 Durch Abtrennen des Ethanols erhält man ITO-Pulver, die sich in Ethanol auf eine Teilchengröße unter 20 nmredispergieren lassen. Die Primärteilchengröße liegt bei 10 bis 11 nm, die spezifische Oberfläche bei 70 m²/g. Isoelektrischer Punkt: 7,2. Der Gehalt an Zinn liegt üblicherweise bei 8 mol-%. Aus diesen Pulvern lassen sich Sol-Gel-Schichten applizieren, die bei einer Filmdicke von 400 nm bei einer 25 Einbrenntemperatur von 550°C auf Glas eine Transmission > 90 % und einen Flächenwiderstand von 160 Ω/□ realisieren können. Der Auftrag mehrerer Schichten ist möglich, wobei der Flächenwiderstand weiter abgesenkt wird. So liegt der erzielte Flächenwiderstand bei einem Zweischichter (600 nm Schichtdicke) bereits bei 100 Ω/□.

Variante 2

In einer Mörsermühle legt man 25 g Ethanol (oder Butanol) und 5,6 g 3,6,9-Trioxadecansäure vor. 75 g erfindungsgemäß hergestelltes ITO-Pulver werden langsam hinzugefügt und es wird 2 h gemahlen. Danach ergibt sich eine dunkelblaue hochviskose Suspension, die für ca. 20 Minuten in einem Walzenstuhl homogenisiert wird. 5 Die so erhaltenen ITO Suspension wird mit 144,4 g Ethanol verdünnt und gerührt.

Nach beiden Varianten wird eine ITO-Suspension mit 30 Gew.-% ITO bzw. 5,4 Vol-10 % Nanopartikeln in Ethanol erhalten. Die Suspension wird für Beschichtungszwecke verwendet (s. oben).

Variante 3

In einen Walzenkneter werden 30 g Ethanol (oder Butanol) oder ein Gemisch 15 Ethylenglycol/Diethylenglycolmonobutylether 50/50) sowie 7,2 g 3,6,9-Trioxadecansäure vorgelegt. Unter Kneten werden 5 x 20 g ITO-Pulver zugegeben und 30 Minuten homogenisiert. Man erhält eine hochviskose dunkelblaue Flüssigsuspension mit einem Feststoffgehalt von bis zu 80 Gew.-% (entspricht 38 Vol.-%). Diese wird in Ethanol dispergiert, indem 40 g der so erhaltenen Suspension in 70 g Ethanol 20 gegeben und gerührt werden (Feststoffgehalt 4,6 Vol.-%).

2. Herstellung eines Targets aus erfindungsgemäßem ITO Material

25 Targets als ITO-Quelle in Sputteranlagen werden in diesem Beispiel durch elektrophoretische Abscheidung hergestellt. Die hierfür verwendete Abscheidezelle besteht aus zwei gegenüberliegenden kreisförmigen, ebenen polierten Elektroden mit einem nutzbaren Durchmesser von 25 mm zwischen denen sich die Suspension befindet. Die Abscheideelektrode besteht aus glasartigem Kohlenstoff und die 30 Gegenelektrode aus nichtrostendem Edelstahl.

Systematische elektrophoretische Abscheideversuche aus der ethanolischen ITO-Suspension (nach obiger Variante 1 hergestellt) mit einem Feststoffgehalt von 30

Gew.% bzw. 5,4 Vol% wurden in Abhängigkeit von der Abscheidedauer (15-60 min) sowie der Abscheidefeldstärke (30-180 V/cm) durchgeführt. Die auf der Abscheideelektrode abgeschiedene Masse der Grünkörper wächst linear mit der angelegten Feldstärke bzw. der Abscheidedauer an. Die auf die Feldstärke (V/cm) und auf die Abscheidedauer (min) normierte abgeschiedene Masse beträgt ca. $3 \cdot 10^{-3}$ g·cm/min·V. Dies entspricht einer normierten Scherbenbildungsgeschwindigkeit (cm/min) von ca. $2,4 \cdot 10^{-4}$ cm·cm/min·V. So wird bei einer Abscheidefeldstärke von 30 V/cm und einer Abscheidedauer von 60 min ein Grünkörper mit einer Dicke von 4,3 mm abgeschieden. Nach der Abscheidung und dem Trennen des ITO-Grünkörpers von der Abscheideelektrode wurden kompakte Grünkörper erhalten, die sich rißfrei trocknen lassen. Die getrockneten ITO-Grünkörper weisen Gründichten von 40 % der theoretischen Dichte auf.

Sinterversuche in atmosphärischen Öfen mit gekapselten ITO-Formkörpern (Grünkörpern; Al₂-O₃-Kapsel) wurden im Temperaturintervall von 1400 - 1600°C drucklos durchgeführt. Mit steigender Sintertemperatur wird eine zunehmende thermische Verdichtung erhalten. Nach einer Sinterdauer von 6 h bei 1600°C wird eine Dichte von 97% der theoretischen Dichte erreicht.

20 3. Herstellung einer Beschichtungsmasse aus erfindungsgemäßem ITO-Material

a) Herstellung eines Böhmitsols (nach DE-A-4338361):

25 0,48 g Essigsäure-stabilisiertes (6,4 Gew.% Essigsäure) Böhmitpulver wurden mit 34,06 g 0,1n HCl versetzt. Es entstand eine transparente farblose Suspension, die direkt zur Herstellung des Sols A weiterverwendet wurde.

b) Herstellung eines Sols A (nach DE-A-4338361):

30 Eine Mischung von 23,63 g Glycidylpropyltrimethoxysilan (GPTS) und 12,50 g Tetraethoxysilan (TEOS) wurde mit 4,86 g des obigen Böhmitsols versetzt. Die Reaktionsmischung wurde 2 Stunden bei Raumtemperatur gerührt und anschliessend unter Eiskühlung mit 11,36 g Aluminiumtributoxyethanolat versetzt. Nach beendeter Zugabe wird das Gemisch weitere 2 h bei 0 °C

gerührt und anschliessend portionsweise mit 29,68 g des obigen Böhmitsols versetzt.

c) Einarbeitung der ITO-Nanopartikel:

5 Eine 40 Gew.%ige (= 6,9 Vol%) Suspension der erfindungsgemäß hergestellten ITO-Nanopartikel (Variante 1) in Wasser (alternativ kann z.B. Ethanol oder Butanol verwendet werden) wird mit dem Sol A gemischt und 12 h bei 25 °C gerührt. Die eingesetzten Mengen an Suspension und Sol A richten sich nach dem gewünschten ITO-Füllgrad (= Vol.-% ITO bzgl. Gesamt-
10 feststoffgehalt) der Schichten.

Mit 28,69 g 40 Gew%-iger bzw. 6,9 Vol%-iger ITO-Suspension und 10,00 g Sol A wird z.B. eine Beschichtung mit einem Füllgrad an ITO von 80 Gew% bzw. 68 Vol% erhalten.

15

d) Verarbeitung zu Schichten:

Mit der Beschichtungsmasse wird Polycarbonat, Glas und Kieselglas über Spin-Coating (Schleudern) beschichtet. Die Substrate wurden vorher mit einem Ar/O₂-Plasma behandelt, aber die Behandlung ist nicht essentiell für die
20 unten beschriebenen Eigenschaften. Die beschichteten Substrate werden entsprechend der Vorschrift für das Bindemittel 2-4 h bei 120-140°C gehärtet.

Die Figur zeigt Absorptionsspektren von Glas mit ITO-freier Schicht (Kurve 1) sowie Glas mit ITO-haltiger Schicht (80 Gew.% bzw. 68 Vol% ITO Füllgrad) (Kurve 2) bei
25 200 bis 2700 nm. Man sieht, daß beide Schichten im sichtbaren Bereich transparent und farblos sind und die ITO-haltige Schicht im NIR Bereich absorbiert.

PATENTANSPRÜCHE

1. Verfahren zur Herstellung von Suspensionen und Pulvern auf Basis von Indium-Zinn-Oxid, dadurch gekennzeichnet, daß man
 - 5 a) Indium-Zinn-Oxid-Vorstufen aus Lösungen von Indium- und Zinn-Verbindungen in einem oder mehreren Lösungsmitteln in Gegenwart einer oder mehrerer oberflächenmodifizierender Komponenten ausfällt,
 - b) das erhaltene Pulver nach Entfernung des Lösungsmittels calciniert,
 - c) eine oder mehrere oberflächenmodifizierende Komponenten und ein oder
 - 10 mehrere Lösungsmittel zugibt,
 - d) die erhaltene Mischung einer Zerkleinerungs- oder Dispergierbehandlung unter Bildung einer Suspension unterwirft und
 - e) gegebenenfalls flüssige Komponenten aus der Suspension abtrennt, um ein Pulver zu erhalten.
- 15 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Indium- und Zinn-Verbindungen Indium(+III)chlorid, Indium(+III)iodid, Indium(+I)chlorid, Indium(+I)iodid, Indium(+III)nitrat, Indium(+III)acetat, Indium(+III)sulfat und/oder Indium(+III)alkoxide bzw. Zinnchlorid, Zinnsulfat und/oder Zinnalkoxide eingesetzt werden, wobei Zinn in der Oxidationsstufe +2 oder +4 vorliegt.
- 20 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß als oberflächenmodifizierende Komponente bei der Fällung und/oder bei der Zerkleinerung oder Dispergierung Mono- oder Polycarbonsäuren, Diketone, Aminosäuren, Polyethylenoxidderivate, Amine oder Säureamide oder Mischungen aus zwei oder mehreren dieser Komponenten eingesetzt werden.
- 25 4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß 3,6,9-Trioxadecansäure, β -Alanin, Tween® 80 und/oder Caprolactam als oberflächenmodifizierende Komponente eingesetzt werden.
- 30

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß zur Fällung der Indium-Zinn-Oxid-Vorstufe eine Base eingesetzt wird.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Calcinierung bei 200 bis 400°C durchgeführt wird.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß unter reduzierenden Bedingungen calciniert wird oder daß nach der Calcinierung reduziert wird.

10

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Zerkleinerung in einem hochsiedenden Lösungsmittel, insbesondere Diethylenglycol oder Diethylenglycolmonobutylether, durchgeführt wird.

15

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Suspension oder das Pulver zu Formkörpern verarbeitet wird.
10. Suspensionen, Pulver und Formkörper auf der Basis von Indium-Zinn-Oxid, erhältlich nach dem Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9.

20

11. Beschichtungs- oder Formmasse, enthaltend eine Suspension oder ein Pulver gemäß Anspruch 10 und gegebenenfalls ein oder mehrere Bindemittel sowie gegebenenfalls ein oder mehrere übliche Additive.

25

12. Verwendung der Indium-Zinn-Oxid-Masse nach Anspruch 11 als Beschichtungsmaterial, insbesondere für mikro- und optoelektronische Zwecke.
13. Verwendung der Indium-Zinn-Oxid-Masse nach Anspruch 11 für Siebdruckpasten oder zur Antistatik-Ausrüstung.

30

14. Verwendung der Indium-Zinn-Oxid-Masse nach Anspruch 11 zur Herstellung von Formkörpern, insbesondere Targets für Sputter-Anlagen.

1/1

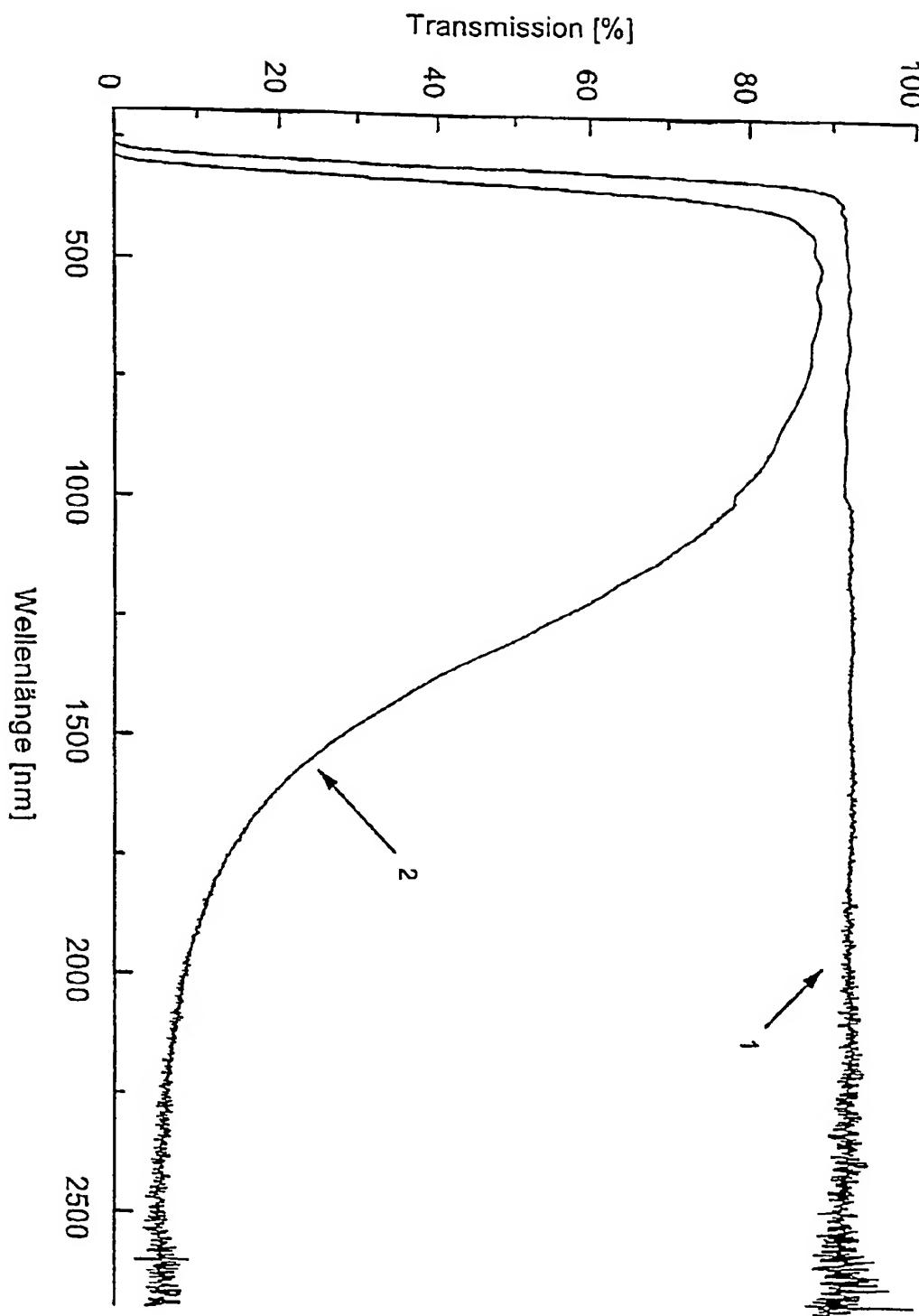


Fig.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.
PCT/EP 99/06498

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 C01G19/00 H01B1/08

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 C01G H01B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 0 578 584 A (EASTMAN KODAK CO ;KODAK PATHE (FR)) 12 January 1994 (1994-01-12) the whole document ---	1-7,9-13
A	US 5 700 419 A (KONDO AKIO ET AL) 23 December 1997 (1997-12-23) the whole document ---	1,9-14
P,X	GOEBBERT: "transparent conducting coatings made from redispersible crystalline nanoscaled powders" MATERIALS RESEARCH SOCIETY SYMP. PROC., vol. 574, 1999, pages 199-204, XP002126707 page 199 -page 201 -----	1-7,9

Further documents are listed in the continuation of box C.

Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

28 December 1999

Date of mailing of the international search report

14/01/2000

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

LIBBERECHT, E

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Inte: **onal Application No****PCT/EP 99/06498**

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)		Publication date
EP 0578584 A	12-01-1994	FR	2691918 A	10-12-1993
		US	5401441 A	28-03-1993
US 5700419 A	23-12-1997	JP	9188564 A	22-07-1997

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inter: nationales Aktenzeichen

PCT/EP 99/06498

A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 C01G19/00 H01B1/08

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestrüpfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 C01G H01B

Recherchierte aber nicht zum Mindestrüpfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	EP 0 578 584 A (EASTMAN KODAK CO ;KODAK PATHE (FR)) 12. Januar 1994 (1994-01-12) das ganze Dokument ---	1-7, 9-13
A	US 5 700 419 A (KONDO AKIO ET AL) 23. Dezember 1997 (1997-12-23) das ganze Dokument ---	1, 9-14
P, X	GOEBBERT: "transparent conducting coatings made from redispersible crystalline nanoscaled powders" MATERIALS RESEARCH SOCIETY SYMP. PROC., Bd. 574, 1999, Seiten 199-204, XP002126707 Seite 199 -Seite 201 -----	1-7, 9



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erforderlicher Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erforderlicher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
28. Dezember 1999	14/01/2000

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentaan 2
NL - 2280 HU Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

LIBBERECHT, E

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

internationales Aktenzeichen
PCT/EP 99/06498

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0578584 A	12-01-1994	FR 2691918 A US 5401441 A	10-12-1993 28-03-1993
US 5700419 A	23-12-1997	JP 9188564 A	22-07-1997